

第4回 SiC 研究会個別討論会

テーマ『ここまできた SiC パワーデバイス。残された課題は何か』

—— 高品質、高信頼化実現に向けて徹底討論 ——

主 催： 社団法人 応用物理学会 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会

日 時： 2009年7月31日（金） 10:20～17:30

会 場： つくば国際会議場 小会議室 303

<http://www.epochal.or.jp/>

茨城県つくば市竹園 2-20-3, TEL:029-861-0001

つくばエクスプレス「つくば駅」から徒歩 10 分

定 員： 約 40 名（事前登録制）

定員を超えた場合は人数調整あり。

会 費： 1000 円（予稿集、コーヒブレイク代含む）

条 件： 討論に全員参加。下記 3 テーマのどれかに連なる話題、たとえば、①課題や問題、②研究成果、③要求性能、④疑問点、等を少なくとも一つ提供すること。

詳 細： <http://annex.jsap.or.jp/scrm/>

申込み： メールにて（独）産業技術総合研究所ESERL 中島小百合まで s-nakajima@aist.go.jp

（問合せは末尾記載の世話人の産総研・先崎または日産自動車・谷本にお願いします）

討論のネタまたは議論したい内容を 50 字～200 字で書き添える。

締切り： 2009年7月10日（金）

***** プログラム *****

10:20-10:25 (5分)

はじめに - 討論会のねらいと議論の進め方- 企画責任者 奥村 元 (産総研)

10:25-11:55 テーマ① 『SBD の現状と課題』

(総合: 30分, ショート: 7分, 質疑応答: 30分)

総合講演「SiC ダイオードの現状と課題」

山本 武雄 (株式会社デンソー)

藤原 広和 (トヨタ自動車株式会社)

渡辺 行彦 (株式会社豊田中央研究所)

ショート講演「高耐電圧 4H-SiC ショットキーバリアダイオードの試作・評価」

宮澤 哲哉 ((財)電力中央研究所)

ショート講演「Si 面、C 面 SBD (JBS)」

木下 明将 ((独) 産業技術総合研究所)

ショート講演「4H-SiC ショットキーバリアダイオードの逆方向特性に対する in-grown 積層欠陥の影響」

原田 真 (住友電気工業株式会社)



11 : 55 - 13 : 00 (昼食)

13 : 00 - 14 : 30 テーマ② 『パワーMOS デバイスの現状と課題』

(総合 : 30 分, ショート : 7 分, 質疑応答 : 30 分)

総合講演「DMOSFET の進展と課題」

北畠 真 (パナソニック(株) 先行デバイス開発センタ)

ショート講演「C 面 4H-SiC MOS ゲート絶縁膜の形成方法とチャネル移動度及び信頼性の関係」

鈴木 拓馬 (株式会社東芝)

ショート講演「Ni オーミックコンタクトの電極剥離問題とその解決」

鈴木 達広 (日産自動車株式会社)

14 : 30 - 14 : 45 (休憩・コーヒブレーク)

14 : 45 - 16 : 15 テーマ③ 『デバイス信頼性に影響するウエハ・プロセス欠陥』

(総合 : 30 分, ショート : 7 分, 質疑応答 : 30 分)

総合講演「4H-SiC DMOSFET の耐圧不良に関する考察」

小杉 亮治 ((独) 産業技術総合研究所)

ショート講演「Al イオン注入された C 面 p n ダイオードの逆方向特性の調査・解析」
辻 崇 (富士電機アドバンステクノロジー株式会社)

ショート講演「SiC イオン注入装置及びアニール装置の現状と課題」

清水 三郎, 大庭昌俊, 鈴木康正, 横尾秀和 (アルバック株式会社)

16 : 15 - 16 : 25 (休憩)

16 : 25 - 17 : 25 総合討論

17 : 25 - 17 : 30 おわりに (予定) SiC 研究会 委員長 播磨 弘 (京都工芸繊維大学)

***** 以上 *****

第 4 回 SiC 研究会個別討論会世話人

産業技術総合研究所

先崎 純寿 (junji-senzaki@aist.go.jp)

電話 : 029-861-2262、FAX : 029-861-5051

日産自動車株式会社

谷本 智 (s-tanimoto@mail.nissan.co.jp)

電話 : 046-867-5193、FAX:046-865-8104